



18.09.2014 - 16:14 Uhr

Samsung startet Massenproduktion der industrieweit ersten 6 Gb LPDDR3 Mobile DRAMs in 20 nm-Technologie

Korea (ots) -

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter <http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs> -

Samsung startet Massenproduktion der industrieweit ersten 6 Gb LPDDR3 Mobile DRAMs in 20 nm-Technologie

Samsung Electronics Co. Ltd., Marktführer bei innovativer Speichertechnologie, hat mit der Massenproduktion seines 6 Gb (Gigabit) Low-Power Double Data Rate 3 (LPDDR3) Mobile DRAM in 20 Nanometer (nm) Prozesstechnologie begonnen. Beim Einsatz des hocheffizienten Mobile Memory Chips in Mobilgeräten mit größeren Displays lassen sich die Batterielaufzeit verlängern und Anwendungen schneller als bisher laden.

"Unser 6Gb LPDDR3 DRAM in 20 nm-Technologie repräsentiert die fortschrittlichste Mobile-Memory-Lösung für den rasch wachsenden Markt leistungsstarker Mobile DRAMs," sagt Jeeho Baek, Vice President, Memory Marketing, Samsung Electronics. "Wir arbeiten intensiv mit unseren Kunden zusammen, um Mobile-Memory-Lösungen der nächsten Generation anbieten zu können, die sich für ein noch größeres Spektrum an Märkten - von Premium bis hin zu Standard-Segmenten - eignen."

Für Samsungs 6 Gb LPDDR3 ist eine Pro-Pin Datenübertragungsrate von bis zu 2.133 Mbit/s spezifiziert. Ein 3 GB (gigabyte) LPDDR3 Package mit vier 6 Gb LPDDR3 Chips kann auf einfache Weise für den Einsatz in einem breiten Spektrum an Mobilgeräten realisiert werden. Auch stärkt das Package unser Produktportfolio für mobile Anwendungen der Premium-Klasse enorm.

Das neue 3 GB Package ist gegenüber dem derzeit verfügbaren 3 GB Package mit 6 Gb LPDDR3 Chips, gefertigt in Samsung bisheriger Prozesstechnologie, über 20 Prozent kleiner und verbraucht etwa zehn Prozent weniger Energie. Dies resultiert in einem Mobile Memory, das extrem klein, unglaublich dünn, beeindruckend schnell und wesentlich leistungseffizienter ist.

Mit dem neuen 20-Nanometer-Prozess von Samsung lässt sich, verglichen mit dem bisherigen Prozess, auch ein Produktivitätsgewinn von über 30 Prozent erzielen. Samsung hat seine 20 nm-Technologie erstmals in der Branche im März für 4 Gb DDR3 für PCs eingesetzt. Nun hat das Unternehmen den Einsatz dieser Technologie auf seine Mobile DRAMs ausgedehnt.

In Zukunft möchte Samsung noch innovativere 20 nm Mobile DRAM Produkte vorstellen, um sein Angebot weiter zu stärken und seine führende Rolle im Bereich High-Density Mobile DRAMs beizubehalten, während sich der Markt um Smartphones mit noch mehr Funktionen, High-End Tablets und "Wearables" erweitert.

Über Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co. Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie, die Menschen überall neue Möglichkeiten eröffnet. Durch kontinuierliche Innovation und Marktbeobachtung transformiert das Unternehmen die Welten der Fernsehgeräte, Smartphones, Tablets, PCs, Kameras, Haushaltsgeräte, Drucker, LTE-Systeme, Medizingeräte, Halbleiter und LED-Lösungen. Bei Samsung Electronics Co. Ltd. sind 286000 Menschen in 80 Ländern beschäftigt. Der jährliche Umsatz des Unternehmens beträgt über US\$216,7 Mrd. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte www.samsung.com.

Über Samsung Semiconductor Europe

Samsung Semiconductor Europe, eine Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co. Ltd. Seoul, Korea, mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt/Main unterhält Büros in ganz Europa und in der Region EMEA (Middle East & Africa). Der europäische Hauptsitz ist für die Marketing- und Verkaufsaktivitäten der Component Business Units von Samsung Electronics zuständig. Dazu gehören die Bereiche Memory, System LSI, LED und Display Business in EMEA. Für mehr Informationen besuchen Sie bitte www.samsung.com/semiconductor.

Samsung und das stilisierte Samsung Design sind Warenzeichen und Servicebezeichnungen von Samsung Electronics Co. Ltd. andere Warenzeichen befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.

Kontakt:

Ujeong Jahnke
Samsung Semiconductor Europe GmbH
Tel. +49(0)6196-66-3300, Fax +49(0)6196-66-23525
Email: ujeong.j@samsung.com